

10/537348

DOCKET NO.: 273516US2PCT

JC20 Rec'd PCT/PTO 03 JUN 2005

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Thierry KRETZ, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/EP03/50918

INTERNATIONAL FILING DATE: December 2, 2003

FOR: ACTIVE MATRIX STRUCTURE FOR DISPLAY SCREEN AND SCREEN COMPRISING SUCH A MATRIX

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:


COUNTRY
France

APPLICATION NO
02 15484

DAY/MONTH/YEAR
03 December 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/EP03/50918.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Marvin J. Spivak
Attorney of Record
Registration No. 24,913
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number
22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

BEST AVAILABLE COPY



15. 03. 2004

22154848
Paris

Best Available Copy

Rec'd PCT/PTO 03 JUN 2005
10/537348

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

COPIE OFFICIELLE

REC'D 23 MAR 2004	
WIPO	PCT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 16 FEV. 2004

EPO - DG 1
15. 03. 2004



Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



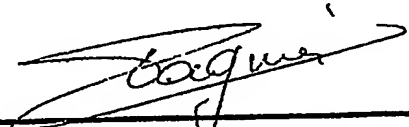
N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260599

REMISE DES PIÈCES DATE 3 DEC 2002 LIEU 75 INPI PARIS F N° D'ENREGISTREMENT 0215484 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI - 3 DEC. 2002		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Mme Agnès DESVIGNES THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13 avenue du Président Salvador Allende 94117 ARCUEIL CEDEX	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 68934			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie 1989			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/>			
Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/>			
Demande divisionnaire <input type="checkbox"/>			
<i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date : ____/____/____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date : ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> <input type="checkbox"/> N° _____ Date : ____/____/____			
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) STRUCTURE DE MATRICE ACTIVE POUR ECRAN DE VISUALISATION ET ECRAN COMPORTANT UNE TELLE MATRICE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		THALES	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 . 5 . 2 . 0 . 5 . 9 . 0 . 2 . 4	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	173 boulevard Haussmann	
	Code postal et ville	75008	PARIS
Pays		FRANCE	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 3 DEC 2002 LIEU 75 INPI PARIS F N° D'ENREGISTREMENT 0215484 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		62934	
6 MANDATAIRE			
Nom		DESVIGNES	
Prénom		Agnès	
Cabinet ou Société		THALES	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		8325	
Adresse	Rue	13 avenue du Président Salvador Allende	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL CEDEX
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 41 48 45 51	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 41 18 45 01	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Agnès DESVIGNES		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

STRUCTURE DE MATRICE ACTIVE POUR ECRAN DE VISUALISATION ET ECRAN COMPORTANT UNE TELLE MATRICE

5 La présente invention se rapporte aux écrans à affichage matriciel, et plus particulièrement à une structure de matrice active d'éléments pixels offrant à la fois une grande capacité de stockage sur chaque électrode pixel et un taux d'ouverture élevé. Le domaine de l'invention est celui des matrices actives formées sur un substrat transparent.

10 Un écran à affichage matriciel est habituellement formé de deux substrats transparents, par exemple en verre, se faisant face, scellés l'un à l'autre par un joint périphérique de façon à ménager une cavité dans laquelle se trouve le matériau d'affichage tel que des cristaux liquides ou des diodes électroluminescentes en matériau organique (OLEDs selon la terminologie
15 anglo-saxonne). Le premier substrat est revêtu d'une contre-électrode, commune à toute la matrice, reliée à un potentiel de référence. Dans le cas d'un écran couleur, ce substrat comporte en outre une matrice de filtres colorés (typiquement, filtres rouges, verts et bleus). Le deuxième substrat comprend les électrodes pixel, arrangées matriciellement en lignes et
20 colonnes. Dans le cas de matrices actives, le deuxième substrat comprend encore des dispositifs de commutation tel qu'un transistor ou une diode, avec un dispositif pour chaque électrode pixel. Chaque dispositif de commutation est connecté à une ligne et à une colonne de la matrice par lesquelles une donnée d'affichage peut être appliquée sélectivement (adressage matriciel)
25 sur l'électrode pixel correspondante.

 La structure formée par l'élément pixel, la portion de contre-électrode en regard et le diélectrique entre, définit une capacité pixel. Cette capacité pixel a une faible valeur. Pour cette raison, une capacité de stockage séparée est prévue dans la structure, associée à chaque électrode pixel,
30 pour maintenir le niveau de tension appliqué sur l'électrode pixel par le dispositif de commutation associé, tout le temps de chaque trame de balayage. Selon le niveau de tension appliqué sur l'électrode pixel, par rapport au niveau de référence de la contre-électrode, on obtient à l'emplacement correspondant sur l'écran un point image blanc (ou vert, rouge
35 ou bleu, dans le cas d'un écran avec filtres couleurs) ou un point image noir.

Le rafraîchissement des images sur l'écran est obtenu selon un mode de balayage de trame : les rangées d'éléments pixel sont sélectionnées tour à tour au moyen d'un signal de balayage appliqué successivement sur chacune des lignes de sélection de rangées de la matrice et les données d'affichage correspondant à chaque rangée sont appliquées sur les colonnes. ~~L'application du signal de balayage de trame sur une ligne a pour~~ effet de rendre passant les dispositifs de commutation de la rangée associée. Chacun de ces dispositifs commute alors la donnée d'affichage appliquée sur la colonne associée, typiquement un niveau de tension, sur l'électrode pixel associée. Le niveau de tension sur l'électrode pixel, doit être maintenu sans pertes, tout le temps de la trame. Or les courants de fuite des transistors à l'état bloqué, et les capacités parasites avec les lignes et les colonnes sont autant de facteurs qui entraînent une décharge de la capacité pixel. On a vu qu'une capacité de stockage séparée avec une valeur adaptée était ainsi prévue, associée à l'électrode pixel, pour cette fonction, dans le but d'obtenir un contraste d'image aussi bon que possible et de réduire les phénomènes de papillotements.

Selon un état de la technique comme décrit par exemple dans l'article intitulé *"Driving method for gate-delay compensation of TFT/LCD"* de K.Kusafuka, H. Shimizu, S.Kimura, paru dans IBM J. Res. Develop. Vol.42 NO.3/4 May/july 1998, une capacité de stockage est habituellement réalisée entre l'électrode pixel et la ligne de sélection de la rangée de pixels précédente. Dans une matrice à éléments de commutation de type transistors, la ligne de sélection réalise la grille des transistors de la rangée, d'où l'appellation "capacité de stockage de grille" (*capacitor on gate* dans la littérature anglo-saxonne), pour cette capacité de stockage réalisée avec cette ligne de sélection. Cependant, avec de telles structures de capacité de stockage, le métal, opaque, de la ligne de sélection empiète sur la surface de l'électrode pixel, ce qui a pour effet de diminuer le taux d'ouverture OAR des pixels (*Open Aperture Ratio*). En pratique, un compromis doit être fait entre la valeur de capacité de stockage que l'on cherche à obtenir et la dégradation du taux d'ouverture des éléments pixel qui serait acceptable. Cette solution s'avère mal adaptée pour les écrans dits haute résolution, pour lesquels les éléments pixels sont déjà de faibles dimensions.

Selon un autre état de la technique, la capacité de stockage peut être réalisée par un plan de masse enterré sous la matrice d'éléments pixel, comme par exemple décrit dans le brevet européen N°0 607 352 (92 922674.4). Une couche en matériau conducteur et transparent, tel que de l'oxyde d'indium et d'étain (ITO) est ainsi réalisée sur toute la surface du substrat, de préférence par-dessus une première couche en matériau opaque conducteur ou non, qui forme écran (*light shield*). Le motif de cette couche opaque est réalisé pour masquer toutes les parties hors de la zone utile d'ouverture des pixels, typiquement les lignes de sélection et les lignes de données, de manière à écranter les lignes de champ des capacités parasites planaires (capacités parasites entre l'électrode pixel et les lignes et les colonnes).

La structure de la matrice active comprenant les éléments de commutation, typiquement des transistors ou des diodes, et les électrodes pixel, est ensuite réalisée selon les procédés technologiques habituels.

La capacité de stockage de chaque élément pixel est alors réalisée à 90% par la structure capacitive entre l'électrode pixel et la portion de plan de masse enterré en regard, et à 10% par la portion de ligne de sélection de la rangée précédente en regard de l'électrode pixel.

Le plan de masse enterré est connecté à un potentiel de référence, typiquement le potentiel de la contre-électrode, au moyen d'un plot de contact externe.

Pour certaines applications des écrans à matrice active, on cherche cependant à réduire les contraintes de connexion externe. La nécessité de connecter le plan de masse à un potentiel de référence apparaît alors comme une contrainte. En effet, des problèmes de croisement avec les autres signaux externes se posent, notamment les signaux de balayage, ce qui rend plus complexe la conception du schéma d'implantation.

Enfin, malgré les couches d'isolant prévues dans la structure de la matrice (en général trois) entre les différents niveaux conducteurs, et selon les technologies de fabrication utilisées, il peut se produire en pratique des courts-circuits entre le plan de masse et les différents niveaux conducteurs de la structure, dus à des poussières ou des impuretés : court-circuits avec les lignes de sélection ou l'électrode pixel. Les électrodes pixel concernées sont alors court-circuitées au potentiel de la contre-électrode : ces pixels

apparaissent donc blancs (ou bien rouges, verts ou bleus, dans le cas d'un écran couleur). Ces défauts visibles affectent le rendement de fabrication.

Un objet de l'invention est de proposer une nouvelle structure de matrice d'écrans de visualisation qui permette de satisfaire aux critères de qualité d'image, malgré une taille réduite des éléments pixels sans ajouter de contraintes de connexion externe et tout en gardant une bonne qualité optique, notamment un taux d'ouverture élevé pour chaque pixel.

Un autre objet de l'invention est une nouvelle structure de la matrice, par laquelle, en cas de court-circuits des éléments pixel avec la capacité de stockage, on ait par construction un noircissement automatique des points image concernés.

Un autre objet de l'invention, est une nouvelle de structure de la matrice, par laquelle les court-circuits entre le plan de masse et les lignes ne soient plus une cause de mise au rebut de la matrice.

L'idée à la base de l'invention est d'utiliser le principe du plan de masse, c'est à dire une couche spécialisée dans la structure de la matrice, mais structurée en larges bus disposés sous les rangées d'électrodes pixel, sensiblement de même largeur que ces rangées, chacun de ces bus étant contrôlé par la ligne de sélection d'une rangée précédente.

Plus particulièrement la structure de matrice selon l'invention comprend alors une couche d'un matériau conducteur transparent, disposée dans la structure sur un niveau séparé du niveau des lignes de sélection de rangée et du niveau des électrodes pixels par une couche d'isolant au moins. Les bus sont disposés de façon parallèle aux lignes de sélection des rangées, et entre ces lignes, sous les rangées d'électrodes pixel, sensiblement de même largeur que les électrodes pixels. Pour chaque élément pixel, on obtient une valeur de capacité de stockage optimum, car la partie du bus en regard de chaque électrode pixel couvre sensiblement toute la surface de cette électrode. Chacun des bus formant une électrode de la capacité de stockage des pixels de la rangée associée est commandé par une ligne de sélection d'une rangée précédente. Aucune connexion externe supplémentaire n'est nécessaire.

Ainsi, telle que revendiquée l'invention concerne une structure de matrice active pour écran de visualisation, formée sur un substrat transparent, comprenant des électrodes pixels disposées en rangées et

colonnes, un dispositif de commutation associé à chaque électrode, et des lignes de sélection de rangée correspondantes, chaque ligne de sélection étant disposée entre deux rangées d'électrodes pixel successives.

5 Selon l'invention, cette structure comprend sous chaque rangée d'électrodes pixel, un bus en matériau conducteur et transparent, sensiblement de même largeur que ladite rangée, réalisé sur un niveau de la structure séparé du niveau des lignes de sélection et du niveau des électrodes pixels par au moins une couche d'isolant et connecté à la ligne de sélection d'une rangée de pixel précédente, ledit bus formant une capacité
10 de stockage avec chaque électrode pixel de ladite rangée.

Cette structure s'applique notamment à des matrices actives du type à transistors à couches minces.

Cette structure selon l'invention permet notamment l'utilisation de dispositifs de commande des lignes de sélection par des signaux
15 d'impulsions à plusieurs niveaux qui permettent de compenser les différentes perturbations désignées par le terme anglo-saxon de "*gate delay*", liées aux capacités parasites du transistor et aux capacités parasites planaires entre l'électrode pixel et les lignes et colonnes voisines, y compris les variations de ces couplages en fonction des caractéristiques du matériau électro-optique
20 utilisé (cristaux liquides) qui varient avec les conditions d'utilisation, par exemple avec la température. L'article précité "*Driving method for gate-delay compensation of TFT/LCD*" décrit de telles formes de signaux de type impulsif, par lesquels les qualités optiques sont améliorées.

Pour des structures de matrice active utilisant des transistors comme
25 dispositifs de commutation, un perfectionnement de l'invention consiste à conformer chacun des bus de capacité de stockage en sorte qu'ils forment une deuxième grille pour chaque transistor de la rangée d'éléments pixels associée. Le bus de capacité de stockage est alors réalisé sur un niveau de la structure tel que cette deuxième grille et la grille principale des transistors,
30 formée par les lignes de sélection de rangée, se trouve de part et d'autre du canal des transistors. On obtient alors une structure de transistor de commutation à double grille.

Par cette deuxième grille qui suit le niveau de tension de la ligne de sélection de la rangée précédente, on améliore la commande à l'état bloqué
35 des transistors de la rangée courante : les courants de fuite sont notamment

limités toute la durée du temps de trame qui suit la sélection de la rangée courante, lorsque les niveaux de tension ont été chargés sur les électrodes pixel et les capacités de stockage associées, ce qui contribue à améliorer le maintien de la charge sur les électrodes pixels, et donc, la qualité de l'image.

5 Selon un autre aspect de l'invention, un avantage supplémentaire de précharge de grille peut encore être obtenu de cette structure de transistors à double grille selon l'invention, en assurant une logique de connexion judicieuse des bus de capacité de stockage avec les lignes de sélection de rangée, en fonction du mode d'adressage de l'écran : inversion trame,
10 inversion ligne, double ligne.

Ainsi, avec une structure de matrice selon l'invention comprenant un bus de capacité de stockage sous chaque rangée d'électrodes pixel selon l'invention, on améliore le rendement de fabrication de la matrice, la valeur de la capacité de stockage, mais aussi la commande des pixels. La qualité
15 optique des écrans qui utilisent de telles matrices s'en trouve améliorée.

De préférence, la connexion de ces bus à la ligne de sélection de rangée associée se fait à l'extérieur de la matrice active, à au moins une extrémité. La connexion de la ligne précédente aux deux extrémités du bus procure l'avantage supplémentaire de permettre l'auto-réparation des lignes
20 de sélection de rangée qui seraient ouvertes, dû à un défaut de fabrication. Pour améliorer la transmission du signal, on peut aussi prévoir de connecter le bus de stockage à la ligne de sélection de rangée précédente, au niveau de chaque électrode pixel. On compense alors les effets de la résistance d'accès élevée des bus de stockage, due au matériau utilisé.

25

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite à titre indicatif et non limitatif de l'invention et en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

-la figure 1 montre représente schématiquement une structure de
30 matrice d'éléments pixels avec des bus de capacité de stockage selon l'invention;

-la figure 2 représente un schéma électrique d'un élément pixel correspondant;

-la figure 3a illustre un exemple d'implantation des couches de fabrication d'une structure d'une matrice d'éléments pixels selon l'invention, pour un transistor à grille dessous, en vue de dessus; et

5 -la figure 3b est une vue en coupe transversale selon un axe II' de la figure 3a;

-les figures 3c et 3d sont respectivement des vues de dessus et en coupe pour illustrer une technique de connexion d'un bus de stockage à la ligne de sélection précédente qui peut être utilisée dans l'invention;

10 -la figure 4a illustre un autre exemple d'implantation des couches de fabrication d'une structure d'une matrice d'éléments pixels selon l'invention, pour un transistor à grille dessus, en vue de dessus; et

-la figure 4b est une vue en coupe transversale correspondante, selon un axe AA';

15 -les figures 5 et 6 représentent chacune une vue en coupe d'une structure de matrice dans laquelle le bus de stockage selon l'invention est conformé de façon à former une deuxième grille de transistors;

-la figure 7 montre un exemple d'implantation d'un bus de stockage conformé pour réaliser cette deuxième grille;

20 -la figure 8 est un schéma électrique d'un élément pixel correspondant;

-les figures 9 et 10 illustrent des modes de connexion avantageux des bus de capacité de stockage à des lignes de sélection précédentes, déterminées en fonction du mode d'adressage des lignes de sélection de rangées; et

25 -la figure 11 illustre les possibilités d'auto-réparation avec un bus de stockage selon l'invention, connecté au moins à ses deux extrémités à une ligne de sélection de rangée précédente.

30 La figure 1 représente schématiquement une matrice active pour écran de visualisation. Des électrodes pixel P sont disposées matriciellement selon un réseau croisé de lignes L_1, \dots, L_m , et de colonnes Col_1, \dots, Col_p .

Les lignes sont sélectionnées successivement, et les données d'affichage correspondantes transmises aux électrodes pixel, au moyen de dispositifs de commande (drivers) 1, 2, bien connus de l'homme du métier.

Chaque électrode pixel couvre une grande partie de la surface encadrée par deux lignes et deux colonnes successives. Sur la figure, la rangée R_n est encadrée par la ligne de sélection associée, L_n , et par la ligne de sélection L_{n-1} de la rangée immédiatement précédente.

5 Selon l'invention, pour chaque rangée d'électrode pixel, un bus de capacité de stockage associé B_n , est prévu sous la rangée d'électrode pixel, sensiblement de même largeur .

10 Ce bus B_n est donc disposé parallèlement, entre les deux lignes de sélection L_n et L_{n-1} . Il est connecté à la ligne de sélection L_{n-1} de la rangée précédente. Dans l'exemple représenté, il est connecté à cette ligne, à l'extérieur de la zone active de la matrice, ZA , par ses deux extrémités.

Ce bus B_n forme une capacité de stockage Cst avec chaque électrode pixel P de la rangée R_n .

15 Une ligne de sélection de rangée supplémentaire L_0 est prévue pour connecter le bus de capacité de stockage B_0 de la première rangée R_0 d'électrodes pixel de la matrice. Typiquement, cette ligne reçoit le même signal de commande que la dernière rangée L_m de la matrice, au moyen d'une connectique adaptée dans le dispositif de commande 1.

20 Un schéma électrique simplifié de l'élément pixel de la rangée R_n et de la colonne Col_i est représenté sur la figure 2. Dans l'exemple, l'élément pixel comprend une électrode pixel P et un transistor T comme dispositif de commutation.

25 Le transistor T a sa grille commandée par la ligne L_n de sélection de rangée, une électrode, typiquement sa source s, connectée à la colonne Col_i , et une autre électrode, typiquement son drain d, connectée à l'électrode pixel P. Une capacité pixel C_{pixel} est formée par la structure empilée entre l'électrode pixel P et la contre-électrode CE. Entre l'électrode pixel P et la ligne de sélection L_{n-1} de la rangée précédente, on trouve une capacité de stockage Cst, formée par la structure empilée entre le bus B_n et l'électrode pixel P. Dans l'exemple, on a une autre capacité de stockage Cst',
30 négligeable devant la première, due à la portion d'électrode pixel P débordant sur la ligne de sélection L_{n-1} de la rangée précédente, comme on peut le voir sur la figure 1.

35 Un exemple de réalisation pratique d'une structure de matrice active à transistors en couches minces, à grille dessous, avec des bus de capacité de

stockage selon l'invention, est représenté sur les figures 3a et 3b. La figure 3a montre l'implantation des différentes couches de la structure (vue de dessus). La figure 3b correspond à une vue en coupe transversale selon l'axe II' représenté sur la figure 3a.

5 Cet exemple d'implantation correspond à un procédé de fabrication à neuf niveaux de masquages.

Dans une première étape, on réalise un premier dépôt de matériau opaque 3, en général conducteur, pour former des bandes à l'endroit des rangées d'électrodes pixel qui seront réalisées sur un niveau supérieur. Dans
10 ces bandes, des ouvertures O sont formées au niveau de chaque électrode pixel, qui définissent la zone utile de chaque pixel (OAR). Cette première étape correspond au premier niveau de masquage. Le matériau opaque utilisé pour former ces bandes de *Light Shield* est typiquement du titane, avec une épaisseur de couche de l'ordre de 100 nanomètres (nm).

15 Dans une deuxième étape, correspondant au deuxième niveau de masquage, on réalise un dépôt de matériau 4 conducteur et transparent, tel que de l'oxyde d'indium et d'étain (de l'ITO, 120 nm d'épaisseur) directement sur le premier niveau, pour former de larges bandes parallèles, à l'endroit des rangées d'électrodes pixel qui seront réalisées sur un niveau supérieur.
20 Les bus de capacité de stockage B_n selon l'invention sont ainsi formés, avec dans cet exemple une structure à double couche 3 et 4.

Puis, on dépose une couche d'isolant, par exemple du SiO_2 , sur une épaisseur de 400 nm.

On réalise alors les lignes L_n de sélection de rangées, qui forment les
25 grilles des transistors. Le matériau conducteur 6 utilisé est typiquement une double couche titane-molybdène (TiMo). Comme il ressort clairement des figures, chaque bus de stockage B_n est encadré par deux lignes de sélection de rangée (métal de grille) L_n et L_{n-1} . Dans l'exemple, la ligne de sélection L_{n-1} de la rangée précédente d'une rangée déborde sur le bus B_n de capacité
30 de stockage de la rangée suivante R_n , pour faciliter la connexion du bus à cette rangée.

Sur le quatrième niveau de masquage, et comme illustré sur les figures 3c et 3d, on grave la couche 5 d'isolation des bus de capacités de stockage, pour former des ouvertures 50, aux extrémités, à l'extérieur de la

zone active (non représenté) en vue de la connexion à réaliser du bus à une ligne de sélection précédente.

Ensuite, de manière habituelle, on procède au dépôt d'une triple couche : isolant de grille 7 (nitrure de silicium, 300nm d'épaisseur), matériau de semi-conducteur (silicium amorphe dopé à la phosphine par exemple) et couche de contact ohmique (silicium amorphe dopé n+ par exemple). On réalise ensuite la délimitation des différents niveaux de façon à former un mesa 8 (figure 3a) de semi-conducteur au-dessus de chaque grille de transistor. On réalise à ce niveau des ouvertures dans l'isolant de grille : des ouvertures 70 au dessus des lignes de sélection et des ouvertures 71 au dessus des ouvertures 50 pour les reprises de contact sur les bus de stockage. C'est le cinquième niveau de masquage.

Sur le sixième niveau, et comme illustré sur les figures 3a et 3b, on forme la couche 9 de conducteur (molybdène) qui définit les colonnes et les électrodes de source et de drain d des transistors, et on utilise les sources et drains comme masques pour créer le canal des transistors.

Sur le septième niveau, on dépose une couche 10 de passivation/isolation, typiquement du nitrure de silicium, et on réalise une ouverture 100, au dessus de chaque drain d, pour permettre la connexion en direct de l'électrode pixel 11, typiquement en ITO, qui est formée sur le huitième niveau.

Un neuvième niveau supplémentaire est en général prévu (non représenté) pour former un méssa en matériau opaque, et isolant (*Light Blocking Layer*) pour protéger le canal des transistors de la lumière.

Comme on peut le voir sur les figures, les bus de stockage sont ainsi réalisés sous les rangées d'électrodes pixel, sensiblement avec une même largeur que ces rangées, et ils sont encadrés par deux lignes de sélection de rangée, la ligne de sélection de la rangée associée au bus, et la ligne de sélection précédente.

Sur la figure 3b, on a représenté les capacités de stockage formées entre l'électrode pixel et le bus de capacité de stockage (Cst) et entre l'électrode pixel et la ligne de sélection de la rangée précédente (Cst').

Les figures 3c et 3d illustrent une technique de connexion dite "tricotage", des bus de stockage avec les lignes de sélection. Une telle technique est utilisée lorsque le niveau d'isolant entre les deux couches à

connecter est fin, une connexion directe entraînant alors des marches trop raides, avec des risques de cassure.

Sur les figures 4a et 4b, on a illustré une variante de réalisation d'une structure de matrice avec un bus de capacité de stockage selon l'invention, combinée avec une structure dite du "shielded pixel".

Le bus de capacité de stockage selon l'invention est ici réalisé sur un niveau de fabrication situé entre les niveaux de fabrication des transistors et le niveau des électrodes pixels, ce qui permet quand le bus de stockage est à un niveau de tension adapté, d'écranter les champs transversaux dus aux capacités parasites planaires. Avec un bus de stockage commandé par une ligne de sélection précédente selon l'invention, et situé sur un tel niveau intermédiaire entre le niveau des électrodes pixel et les niveaux conducteurs des transistors (lignes, colonnes), on bénéficie de cet effet d'écrantage dès lors que la ligne de sélection est non sélectionnée, ce qui est le cas la majeure partie du temps que dure la trame.

Dans l'exemple, les transistors en couches minces sont du type à grille dessus. Dans l'exemple, le bus de capacité de stockage est disposé au-dessus du transistor, entre le niveau de grille de transistor du type à grille dessus et le niveau d'électrode pixel P. Si on prend la figure 4b correspondant à une vue en coupe transversale le long de l'axe AA', les niveaux source/drain, et canal du transistor qui n'apparaissent pas sur cette coupe, sont situés sous le niveau des lignes de sélection (grille).

Selon un autre aspect de l'invention, que l'on peut combiner avec les différents modes de réalisation précédents, on prévoit que le bus de capacité de stockage B_n commandé par une ligne de rangée précédente L_{n-1} , déborde sur la ligne de sélection L_n de la rangée R_n , et se situe sur un niveau de la structure de la matrice situé à l'opposé des lignes de sélection de grille par rapport au niveau de canal des transistors. On obtient alors une structure de transistor à double grille, avec une grille principale connectée à la ligne de sélection de la rangée considérée, et une grille auxiliaire connectée à la ligne de sélection de la rangée précédente L_{n-1} .

Une structure correspondante de transistor de commutation et son électrode pixel P associée dans une rangée R_n de la matrice est illustrée sur la figure 5, dans un exemple de transistor à grille dessus. Le transistor exemple de réalisation d'une deuxième grille des transistors T d'une rangée

a une grille principale g_1 du transistor, formée par la ligne de sélection L_n de la rangée R_n dans la portion de cette ligne au-dessus du canal c ; et une grille auxiliaire g_2 , formée par la portion du bus de capacité de stockage B_n , au-dessous dans le cas de la figure 5. Cette deuxième grille g_2 est donc commandée par le signal de la rangée L_{n-1} .

La figure 6 illustre une autre variante de réalisation d'une deuxième grille qui utilise le bus de capacité de stockage de la rangée suivante : La deuxième grille des transistors T d'une rangée R_n , est formée avec le bus de capacité de stockage B_{n+1} de la rangée suivante. Dans l'exemple représenté, sur cette figure, le transistor est du type à grille dessous. La grille principale g_1 du transistor est formée par la ligne de sélection L_n de la rangée R_n dans la portion de cette ligne au-dessus du canal c ; et la grille auxiliaire g_2 est formée par la portion du bus de capacité de stockage B_{n+1} , au-dessus du canal c . Cette deuxième grille g_2 est ici commandée par le signal de la rangée L_n .

Les deux variantes de réalisation de la deuxième grille, avec le bus de la rangée (figure 5) ou avec le bus de la rangée suivante (figure 6) s'appliquent chacune aussi bien à des transistors à grille dessous ou dessus.

Si on reprend la variante de réalisation de la figure 5, on prévoit, pour réaliser le débordement du bus de capacité de stockage B_n sur la ligne de sélection L_n de la rangée associée R_n , que le bus B_n soit conformé pour venir recouvrir en partie au moins la zone de canal de chaque transistor de la rangée R_n . Dans l'exemple représenté sur la figure 7, le bus de capacité de stockage B_n comporte ainsi une excroissance verticale V vers le bas au niveau de chaque transistor. Cette excroissance a une forme de botte correspondant au mesa 8 (figure 3a), de façon à recouvrir la totalité du canal. Il faut alors prévoir un évidement correspondant E dans la forme du bus suivant B_{n+1} , afin d'éviter les court-circuits entre les deux bus B_n et B_{n+1} .

On peut éviter ce problème en prévoyant de ne former une grille que sur une partie du canal, par exemple avec une excroissance ne recouvrant que la moitié de la longueur du mesa, dans le sens vertical. En contrepartie, les effets de blocage seront moindres, et on aura une moins bonne tenue en tension de la deuxième grille ainsi formée. Dans tous les cas, la forme du bus est déterminée pour tenir compte des désalignements possibles des masques.

Dans le cas de la figure 6, où la deuxième grille est formée avec le bus de capacité de stockage de la rangée suivante, le bus B_{n+1} est par exemple conformé avec une excroissance correspondante à celle montrée sur la figure 7, mais vers le haut. Le bus B_n étant éloigné, on n'a pas ici de problème de court-circuit entre les bus B_n et B_{n+1} .

La figure 8 est un schéma électrique correspondant d'un élément pixel à transistor à double grille selon l'invention dans la variante de réalisation illustrée sur les figures 5 et 7.

Un avantage d'une structure à double grille de transistor selon l'invention, est de pouvoir conforter le niveau de blocage de grille des transistors de chaque rangée, tant que la ligne de sélection qui commande le bus de capacité de stockage qui forme la deuxième grille n'est pas sélectionné. La qualité optique est améliorée.

Dans le cas où cette grille est formée avec le bus B_n de capacité de stockage de la rangée R_n elle-même, et donc commandée par la ligne L_{n-1} de sélection de rangée précédente (figures 5, 7, 8), cette structure de matrice à transistors à double grille permet en outre, de bénéficier d'un effet de précharge de grille, qui améliore le temps d'accès de la matrice. L'effet technique est un début de précharge de grille des transistors de la rangée R_n , lorsque la ligne de sélection qui commande le bus de stockage de cette rangée est sélectionnée.

Pour obtenir un tel effet de précharge, il faut cependant tenir compte du mode d'adressage de l'écran dans lequel la matrice va être intégrée. En effet, selon le type d'application considérée, la polarité de la tension appliquée comme signal de sélection sur les grilles des transistors, peut varier de trame en trame et/ou de ligne en ligne. Or on ne peut avoir un effet positif de précharge de grille, que si la ligne de sélection qui commande le bus de capacité de stockage de la rangée considérée est commandée avec la même polarité que la ligne de sélection de cette rangée. Le rang de la rangée précédente à connecter au bus de capacité de stockage de la rangée de rang n dans la matrice, doit alors être déterminé en fonction du mode d'adressage de l'écran de visualisation dans lequel la matrice doit opérer.

Dans le cas où la polarité est inchangée dans une trame, il n'y a pas de problèmes. Ainsi, le bus de capacité de stockage peut être commandé avec la ligne de sélection immédiatement précédente : B_n est commandé par

L_{n-1} , comme décrit précédemment. On a cette même logique de connexion dans le cas où la polarité est seulement inversée de trame en trame : sur une trame, la polarité est positive (+6 volts), sur la trame suivante, la polarité est négative (-6 volts) et ainsi de suite.

5 En fait, la logique de connexion change dès lors que, la polarité des lignes change au sein même de la trame

On trouve principalement deux modes d'adressage de ce type : le mode inversion ligne, adapté aux écrans couleurs avec une structure de filtres couleurs dite de type "*stripe*" et le mode inversion double ligne, adapté
10 aux écrans couleurs avec une structure de filtres couleurs dite de type "*quad*".

La figure 9 illustre le cas d'une structure de matrice pour une utilisation avec une structure de filtres de type stripe : un point image I est défini par trois points élémentaires situés sur la même rangée, chaque point
15 correspondant à une couleur : rouge (R), vert (V), bleu (B).

Pour une telle matrice, on utilise en général un mode d'adressage faisant intervenir une inversion ligne : pendant une trame i, on applique des polarités alternées de ligne en ligne, à la trame suivante, on inverse.

Les lignes de sélection qui reçoivent la même polarité de signal de
20 balayage sont séparées par une ligne.

La figure 10 illustre le cas d'une structure de matrice pour une utilisation avec une structure de filtres de type quad : un point image I est défini par quatre points élémentaires alignés sur deux rangées consécutives.

Pour une telle matrice, on utilise en général un mode d'adressage
25 faisant intervenir une inversion double ligne : pendant une trame i, on applique des polarités alternées de deux lignes en deux lignes, à la trame suivante, on inverse, en sorte que tous les points élémentaires d'un même point image aient une même polarité de signal de grille. Il faut raisonner par paires de lignes.

30 Ainsi, le bus de capacité de stockage B_n de la rangée de rang n de la matrice est alors connecté à la ligne de sélection précédente de rang n-4.

On notera que le principe de connexion explicité en relation avec les figures 9 et 10 s'applique aussi si le mode d'adressage fait intervenir une inversion colonne en plus de l'inversion ligne ou double ligne.

Avec les différentes variantes de réalisation d'une structure de matrice selon l'invention, on améliore le rendement de fabrication par le noircissement automatique des éléments pixels en court-circuit avec le bus, 99% du temps de balayage de trame (ie, quand la ligne de sélection qui
 5 commande ce bus n'est pas sélectionnée).

On peut encore améliorer le rendement de fabrication en prévoyant que la connexion des bus de stockage à la ligne de sélection précédente déterminée, soit réalisée à l'extérieur de la zone active de la matrice, aux deux extrémités e1 et e2 du bus de capacité de stockage comme représenté
 10 schématiquement sur la figure 11.

En effet, le signal de sélection (ou de balayage) s de la rangée R_{n-1} est alors amené par les deux côtés de la ligne de sélection L_{n-1} , d'un côté, par l'application directe sur cette ligne par le dispositif de commande des lignes, et de l'autre, par le bus de capacité de stockage, par son extrémité e2.

15 Si la ligne de sélection L_{n-1} est ouverte, dû à un défaut de fabrication, ce signal s est cependant amené sur chaque élément pixel de la rangée. On améliore ainsi le rendement de fabrication.

Par ailleurs les court-circuits possibles entre un bus de capacité de stockage et une ligne de sélection ne sont plus gênants dans cette structure, 20 puisque par construction, ils véhiculent le même signal électrique. Ils contribuent plutôt à faire diminuer la résistance d'accès du bus de stockage.

En connectant le bus de capacité de stockage à la ligne de sélection précédente au niveau de chaque électrode pixel, on peut résoudre le cas où la même ligne est ouverte en plusieurs points. On compense aussi les effets
 25 de résistance d'accès du bus de capacité de stockage, dû au matériau utilisé, qui n'est pas favorable à une propagation rapide du signal.

On notera que cette dernière variante de connexion n'est pas applicable facilement dans les cas où la ligne de sélection précédente à laquelle le bus de capacité de stockage doit être connecté n'est pas celle
 30 immédiatement précédente : en d'autres termes, dans le cas où l'on souhaite bénéficier des avantages de précharge de grille avec une structure à double grille, en mode d'inversion ligne ou double ligne, on ne connectera pas le bus de capacité de stockage au niveau de chaque électrode pixel, mais seulement à ses extrémités e1 et e2.

La structure de matrice selon l'invention, avec ses différentes variantes de réalisation s'applique aux différents types de transistors à couches minces, à silicium amorphe, mono- ou poly-cristallin. Pour les variantes qui ne concernent pas la structure même du transistor, elle s'applique à tout dispositif de commutation utilisé dans le domaine des matrices actives.

Cette structure de matrice s'applique à des écrans de visualisation qui utilisent des cristaux liquides, mais aussi d'autres matériaux ou structures électro-optiques tels que les OLED's.

REVENDICATIONS

1. Structure de matrice active pour écran de visualisation, formée sur un substrat transparent, comprenant des électrodes pixels (P) arrangées en rangées et colonnes, un dispositif de commutation associé à chaque électrode, et des lignes de sélection de rangée correspondantes, chaque ligne de sélection (L_n) étant disposée entre deux rangées d'électrodes pixel successives (R_{n-1} , R_n), caractérisée en ce que qu'elle comprend sous chaque rangée (R_n) d'électrodes pixel, un bus (B_n) en matériau conducteur et transparent, sensiblement de même largeur que ladite rangée, réalisé sur un niveau de la structure séparé du niveau des lignes de sélection (L_n) et du niveau des électrodes pixels (P) par au moins une couche d'isolant et connecté à la ligne de sélection (L_{n-1}) d'une rangée d'électrodes pixel précédente, ledit bus formant une capacité de stockage (Cst) avec chaque électrode pixel de ladite rangée.
2. Structure de matrice active selon la revendication 1, caractérisée en ce que chaque bus (B_n) de capacité de stockage est connecté à une ligne de sélection de rangée (L_{n-1}) précédente à l'extérieur d'une zone active (ZA) de la matrice, à au moins une extrémité (e1).
3. Structure de matrice active selon la revendication 2, caractérisée en ce que chaque bus de capacité de stockage est connecté à ses deux extrémités (e1, e2) à ladite ligne de sélection de rangée précédente, à l'extérieur de la zone active.
4. Structure de matrice active selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisée en ce que chaque bus de capacité de stockage est connecté à ladite ligne de sélection de rangée au niveau (e3) de chaque élément pixel de la rangée associée.

5. Structure de matrice active selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les dispositifs de commutation sont des transistors (T), la ligne de sélection d'une rangée (R_n) formant grille (g1) pour chacun des transistors de cette rangée.

6. Structure de matrice active selon la revendication 5, caractérisée en ce que le niveau de canal (c) des transistors est situé entre le niveau des bus de capacité de stockage (B_n) et celui des lignes de sélection de rangée formant grille (g1) des transistors (T) et en ce que pour chaque transistor d'une rangée, une portion au moins du bus de capacité de stockage (B_{n+1}) de la rangée suivante chevauche le canal du transistor, ladite portion de bus opérant comme une deuxième grille (g2) pour ledit transistor.
7. Structure de matrice active selon la revendication 5, caractérisée en ce que le niveau de canal (c) des transistors est situé entre le niveau des bus de capacité de stockage (B_n) et celui des lignes de sélection de rangée formant grille (g1) des transistors (T) et en ce que pour chaque transistor d'une rangée, une portion au moins du bus de capacité de stockage (B_n) de la rangée chevauche le canal du transistor, ladite portion de bus opérant comme une deuxième grille (g2) pour ledit transistor.
8. Structure de matrice active selon la revendication 7, caractérisée en ce que le bus (B_n) de capacité de stockage d'une rangée (R_n) de rang n dans la matrice est connecté à une ligne de sélection de rangée précédente, le rang de la dite rangée précédente étant déterminé en fonction du mode d'adressage de l'écran de visualisation dans lequel la matrice doit opérer.

9. Structure de matrice active selon la revendication 8, caractérisée en ce que pour un mode d'adressage faisant intervenir une inversion ligne, le bus de capacité de stockage de la rangée de rang n est connectée à la ligne de sélection de la rangée de rang $n-2$.
10. Structure de matrice active selon la revendication 8, caractérisée en ce que pour un mode d'adressage faisant intervenir une inversion double-ligne, le bus de capacité de stockage de la rangée de rang n est connectée à la ligne de sélection de la rangée de rang $n-4$.
11. Structure de matrice active selon l'une quelconque des revendications 5 à 10, pour un transistor du type à grille dessous, caractérisé en ce que le bus de capacité de stockage est réalisé sur un niveau disposé au-dessus des niveaux des lignes de sélection et des lignes de données.
12. Structure de matrice active selon l'une quelconque des revendications 5 à 10, pour un transistor du type à grille dessus, caractérisé en ce que le bus de capacité de stockage est réalisé sur un niveau disposé au-dessous des niveaux des lignes de sélection et des lignes de données, directement sur un substrat, ou sur un niveau de masque optique.
13. Ecran de visualisation comprenant une structure de matrice active selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 12.
14. Ecran de visualisation selon la revendication 13, comprenant une structure de matrice active selon l'une quelconque des revendications 5 à 12, caractérisé en ce que les lignes de sélection de rangées sont commandées par un signal d'adressage ligne du type impulsionnel à plusieurs niveaux de tension.

1/8

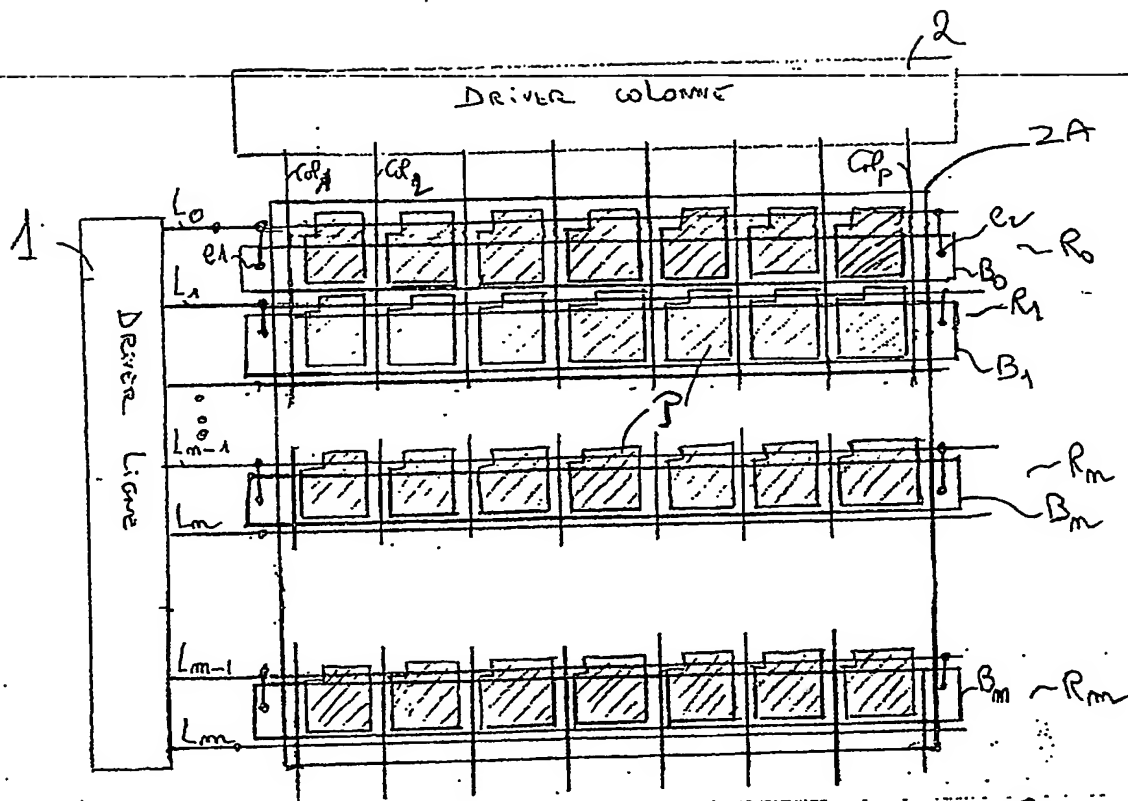


FIG. 1

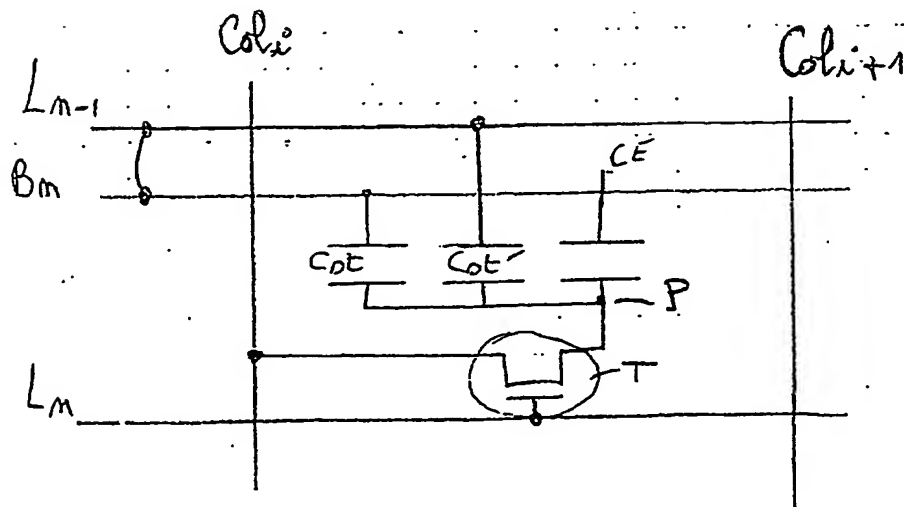


FIG. 2

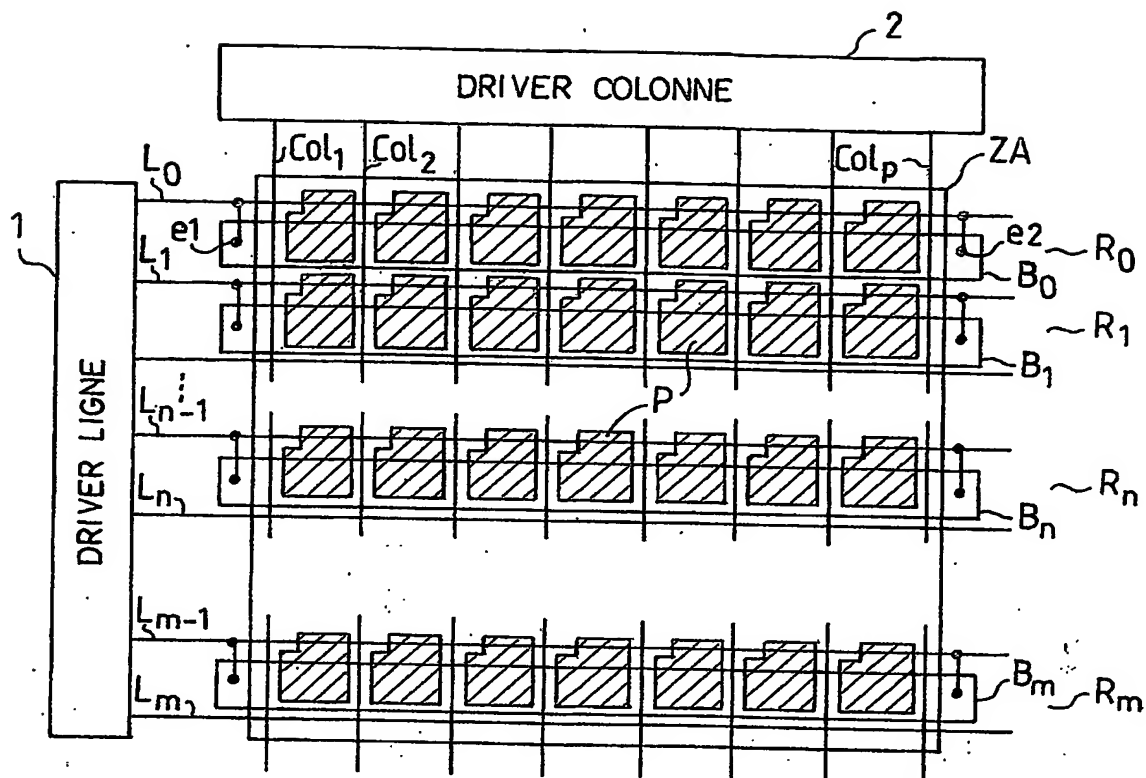


FIG. 1

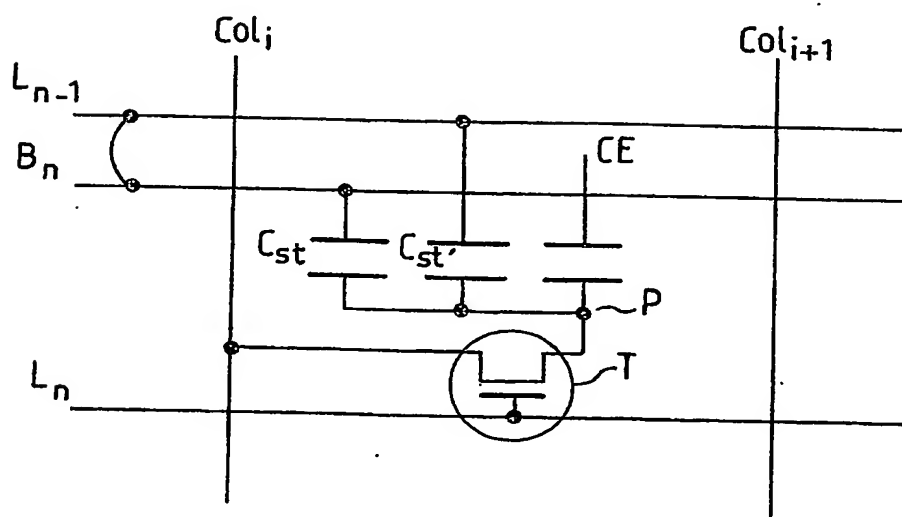


FIG. 2

1

$$C_{i+1}$$

Colit+2

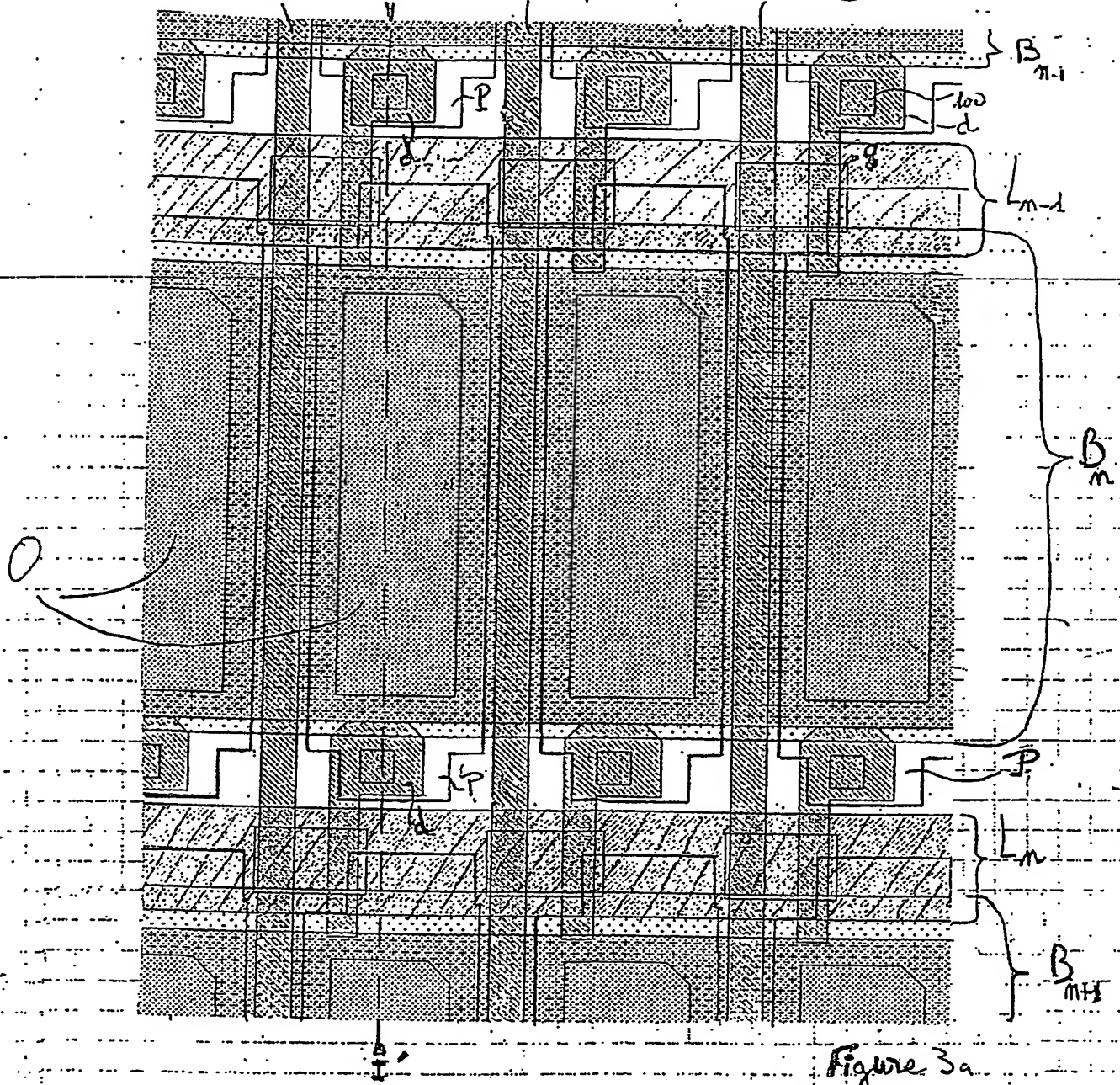


Figure 3a

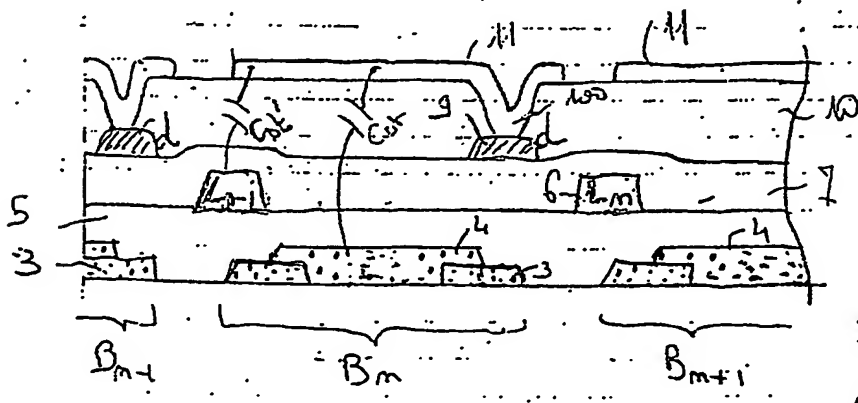


Figure 3.6

(coupe transversale
selon [II'])

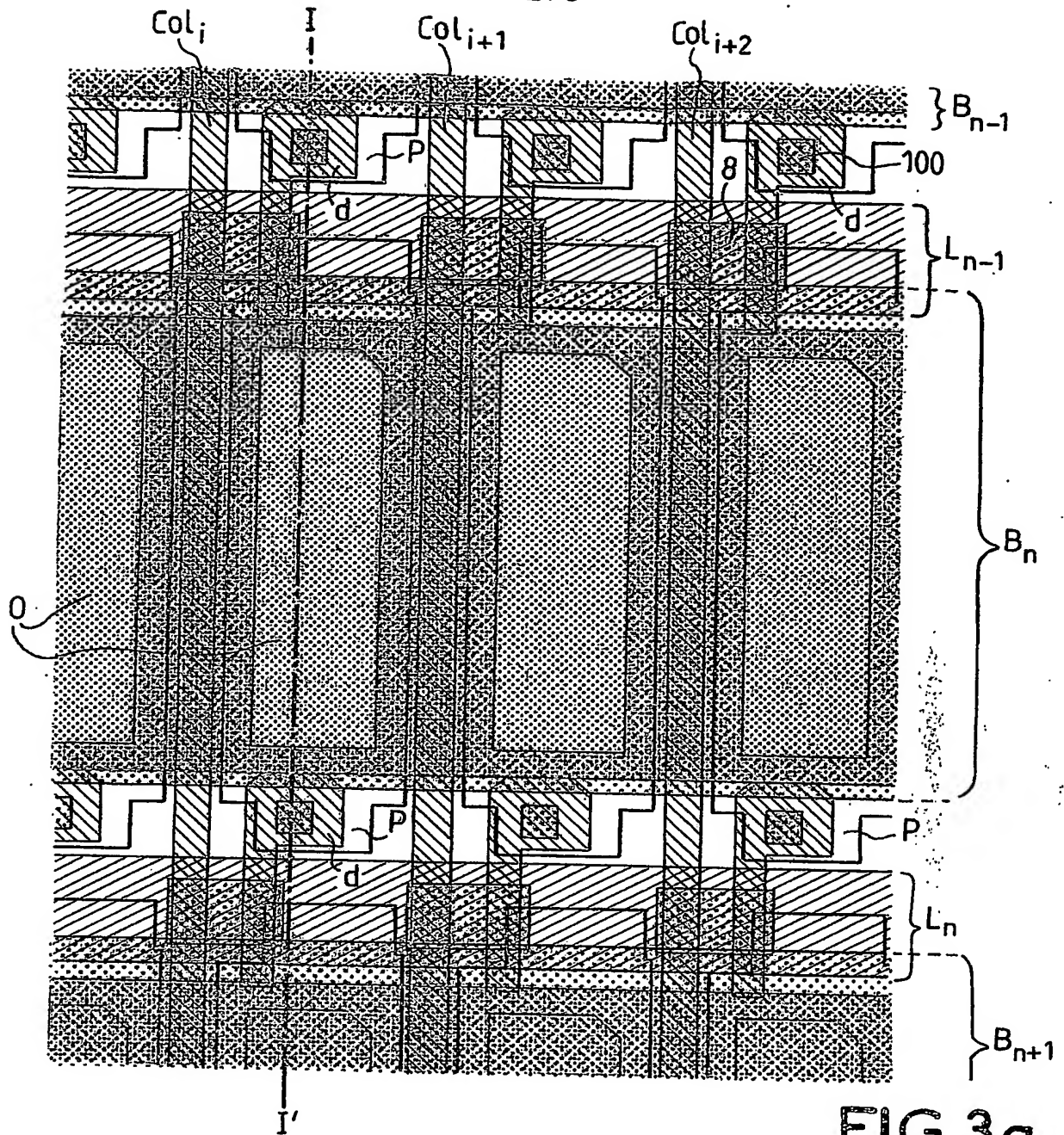


FIG. 3a

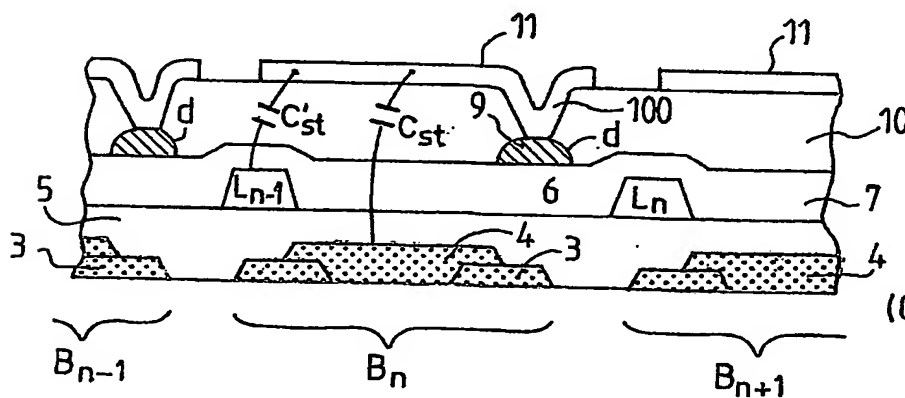
(Coupe transversale
selon [II'])

FIG. 3b

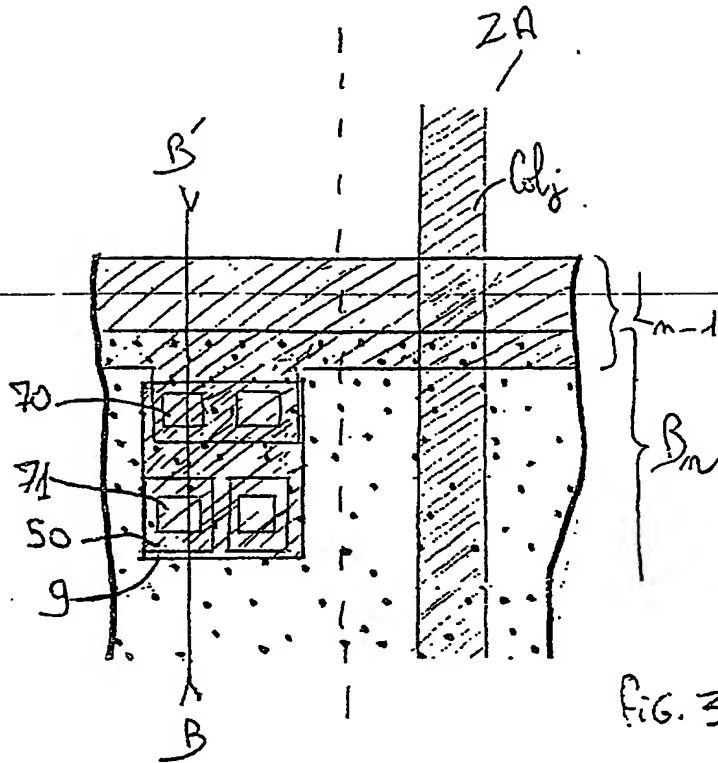


FIG. 3c

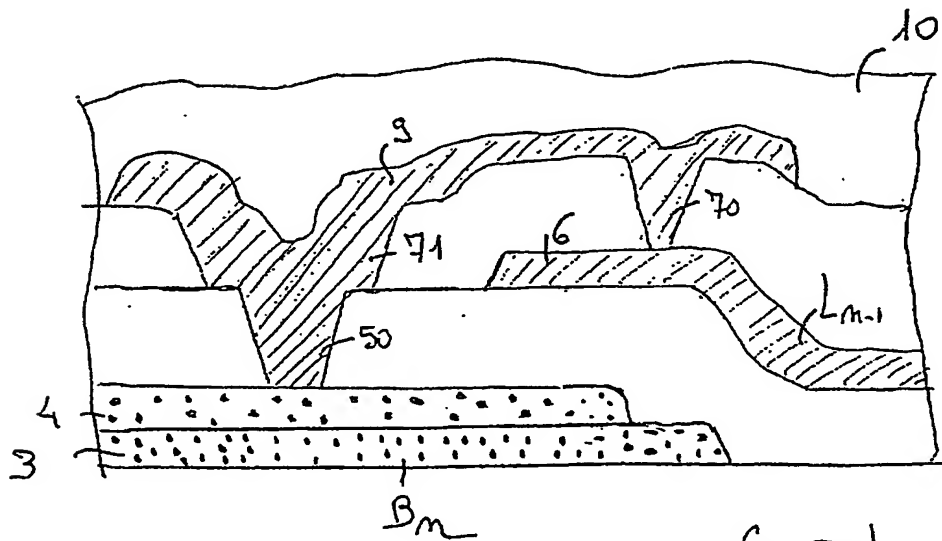


FIG. 3d

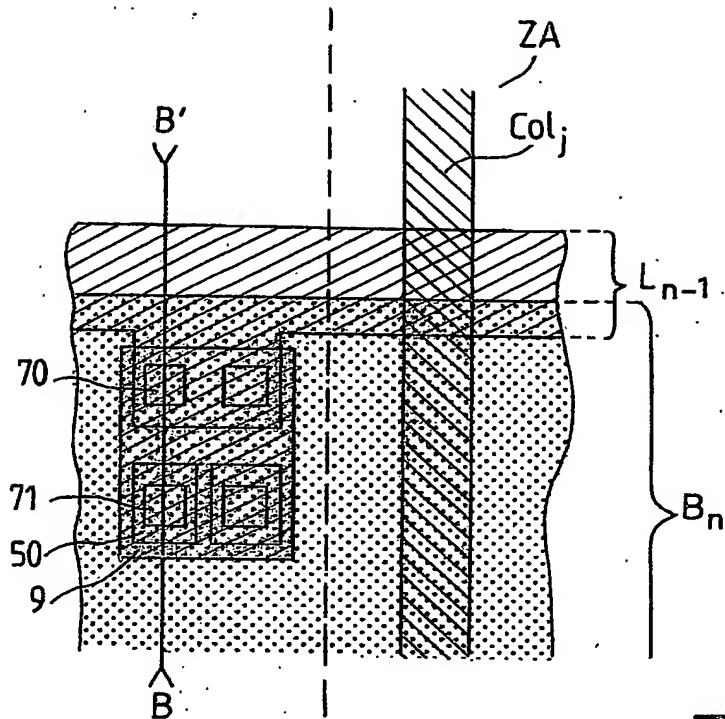


FIG. 3c

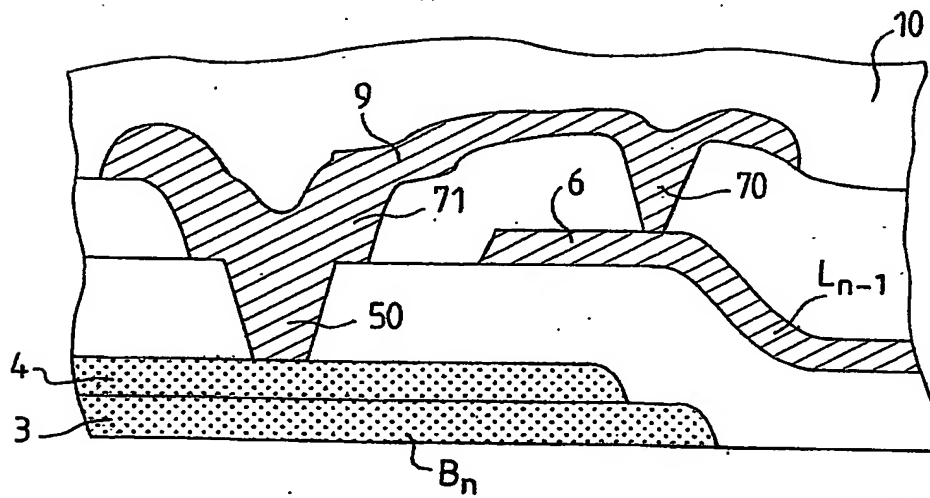
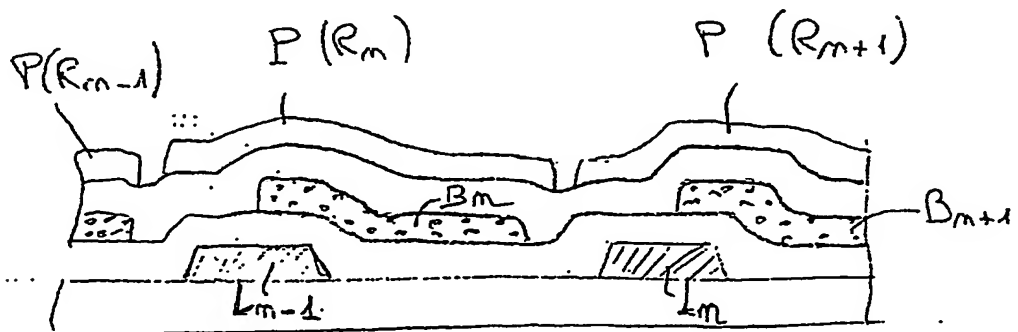
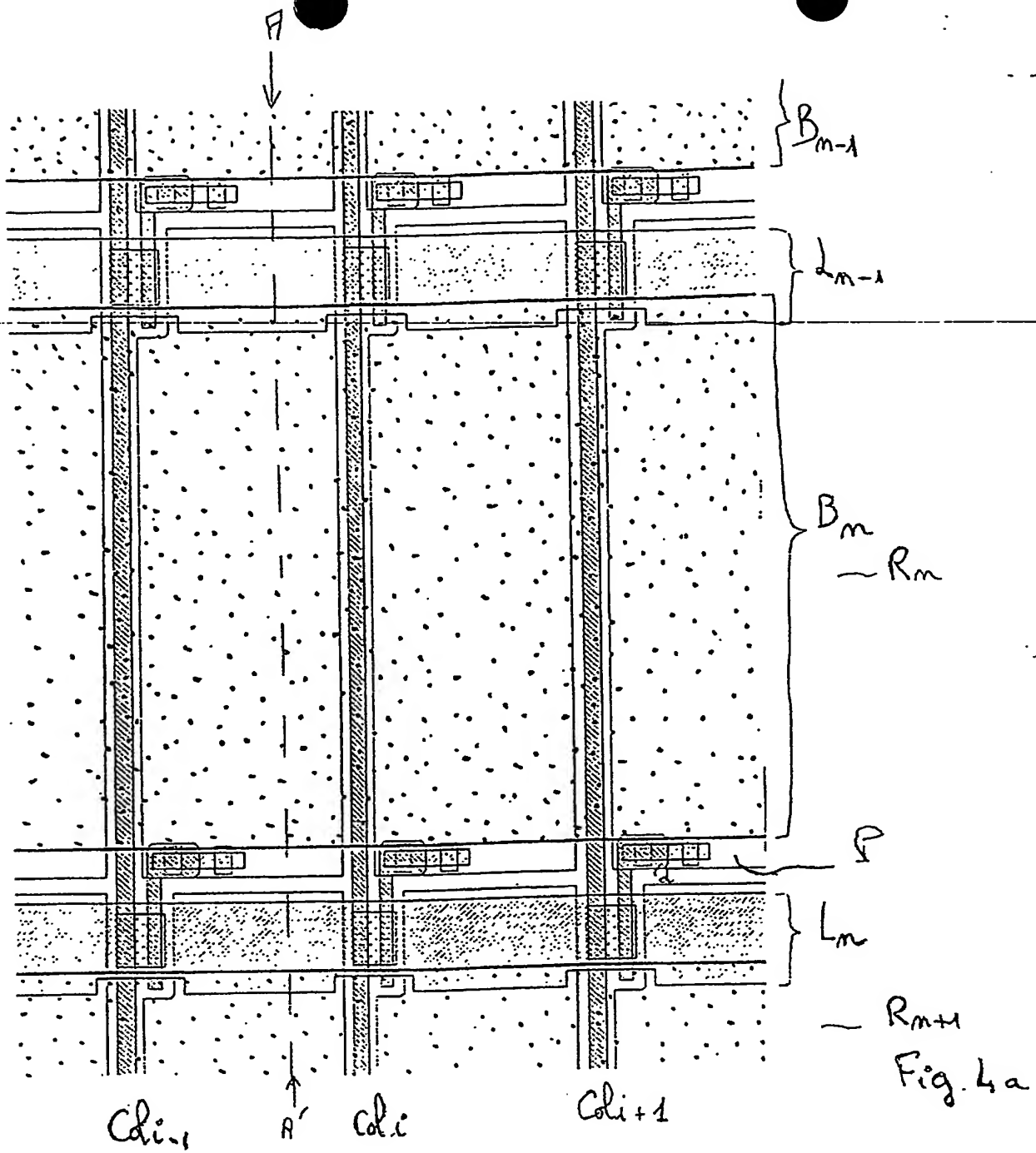


FIG. 3d

4/8



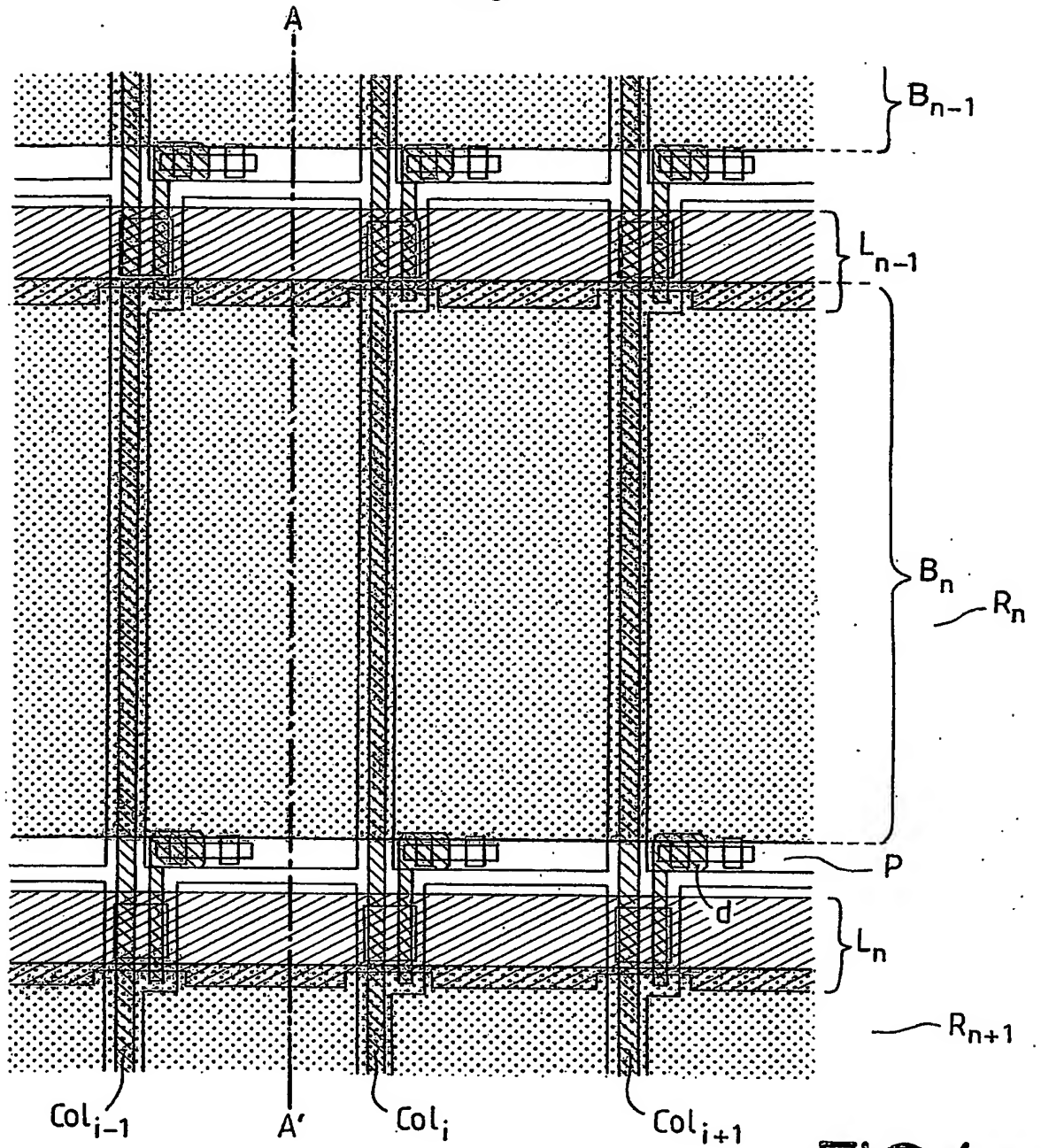


FIG. 4a

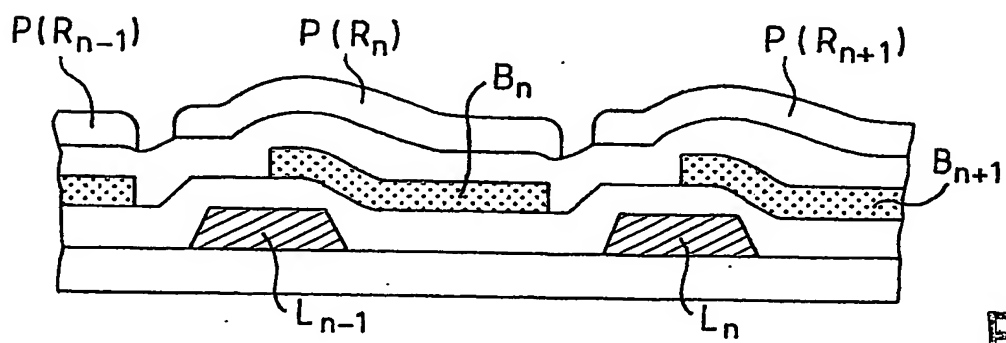


FIG. 4b

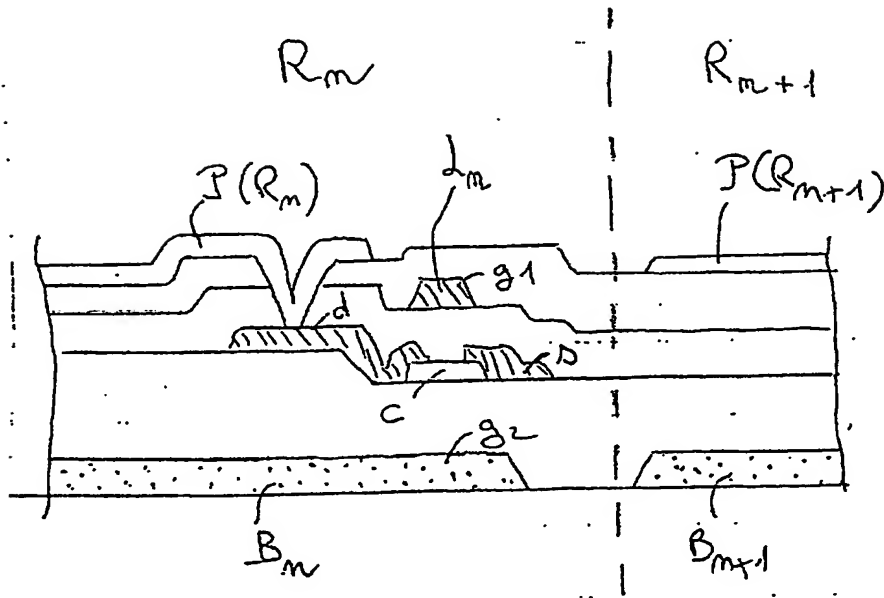


FIG. 5.

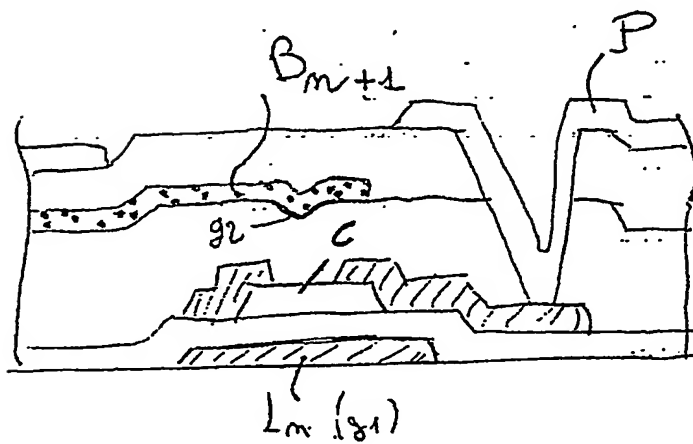


FIG. 6.

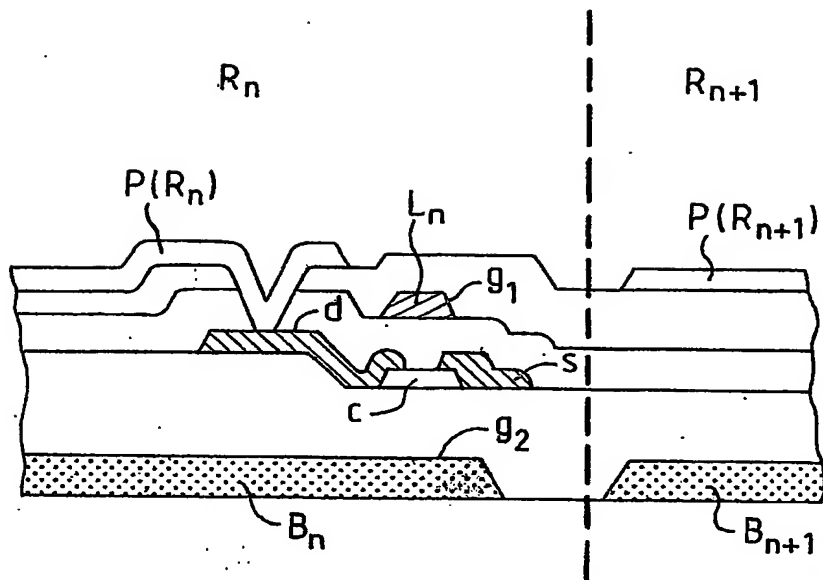


FIG.5

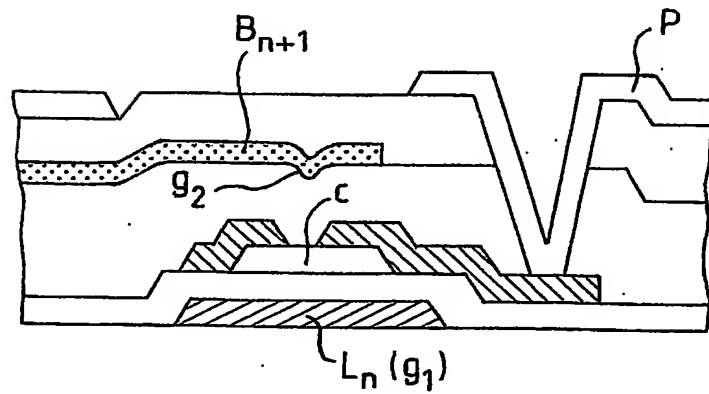


FIG.6

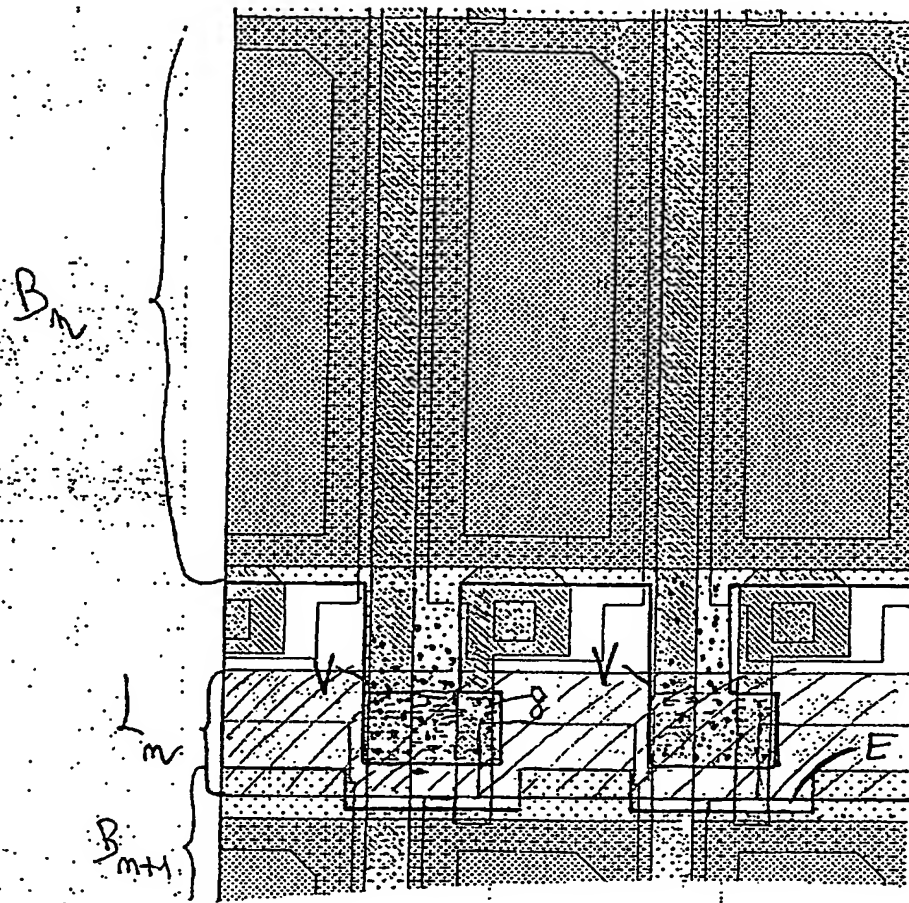


Fig 7

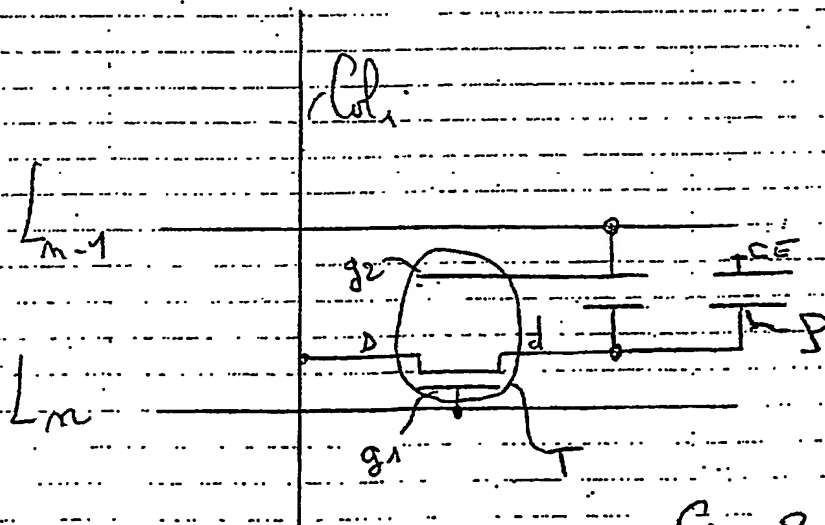


Fig. 8

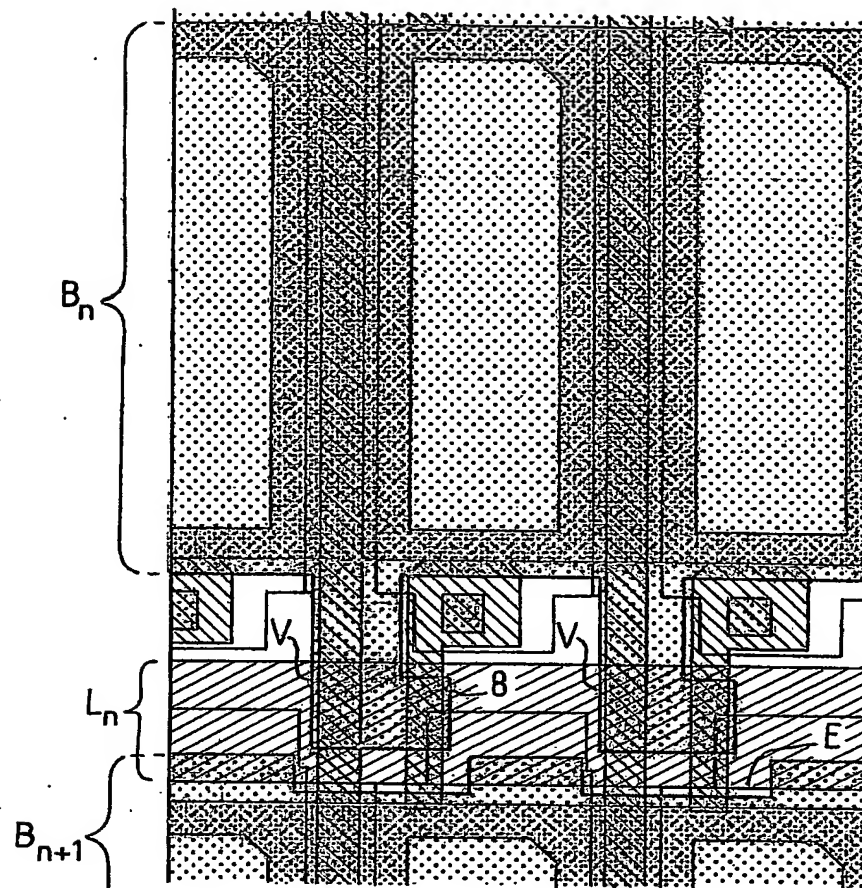


FIG. 7

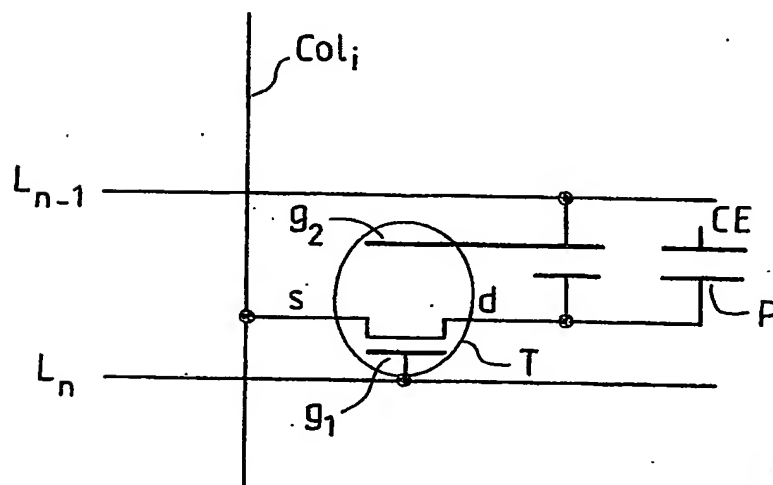


FIG. 8

4/8

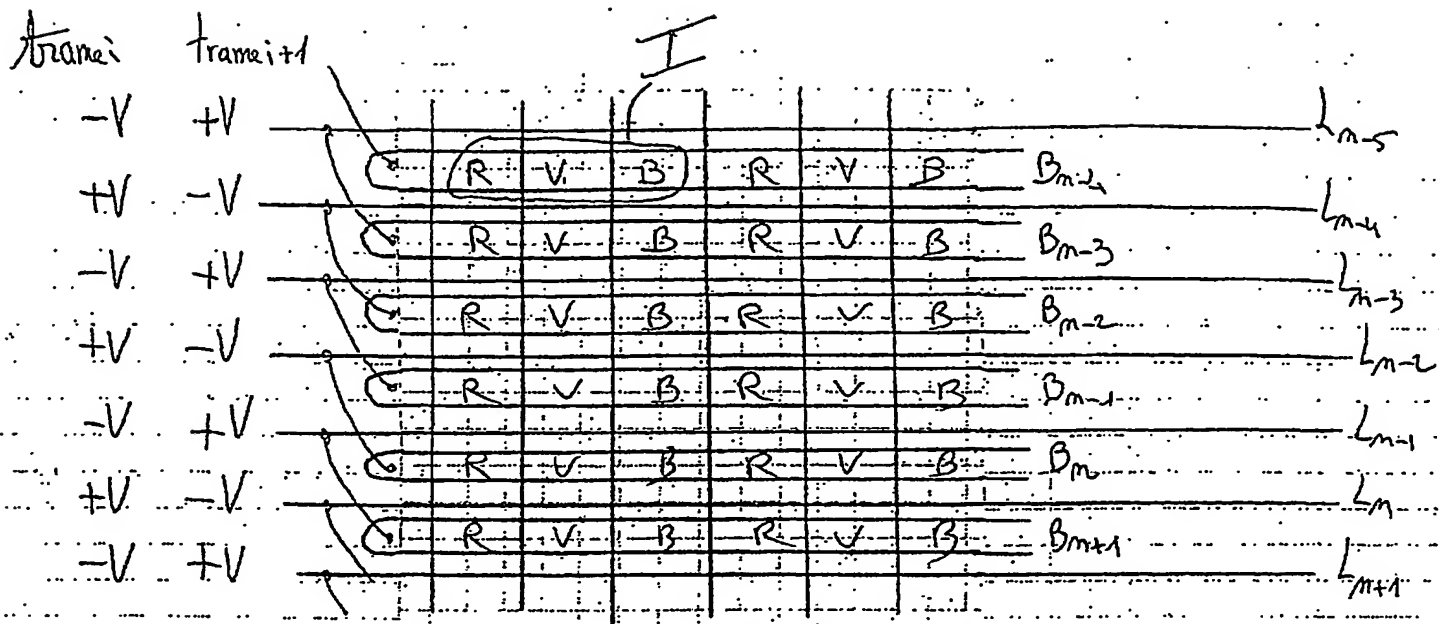


FIG. 9

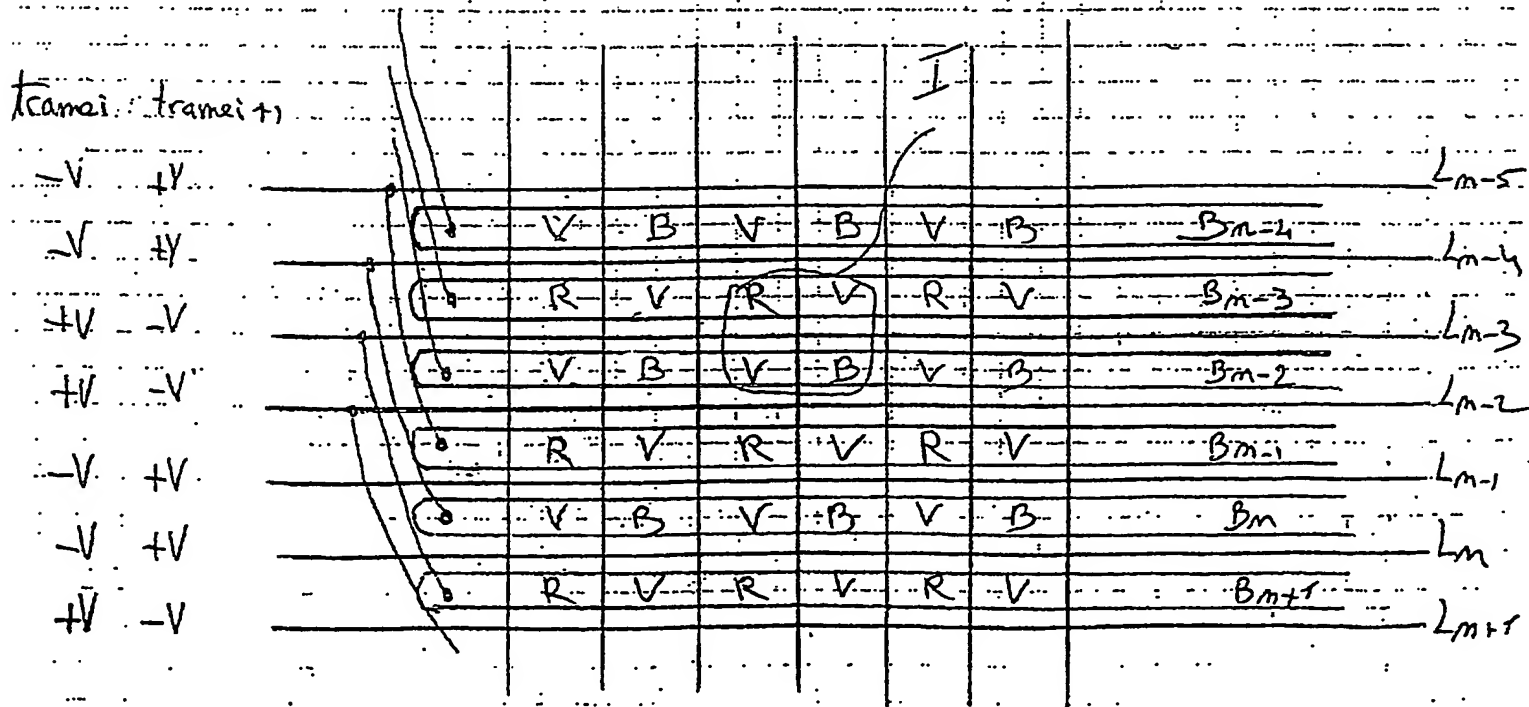


FIG. 10

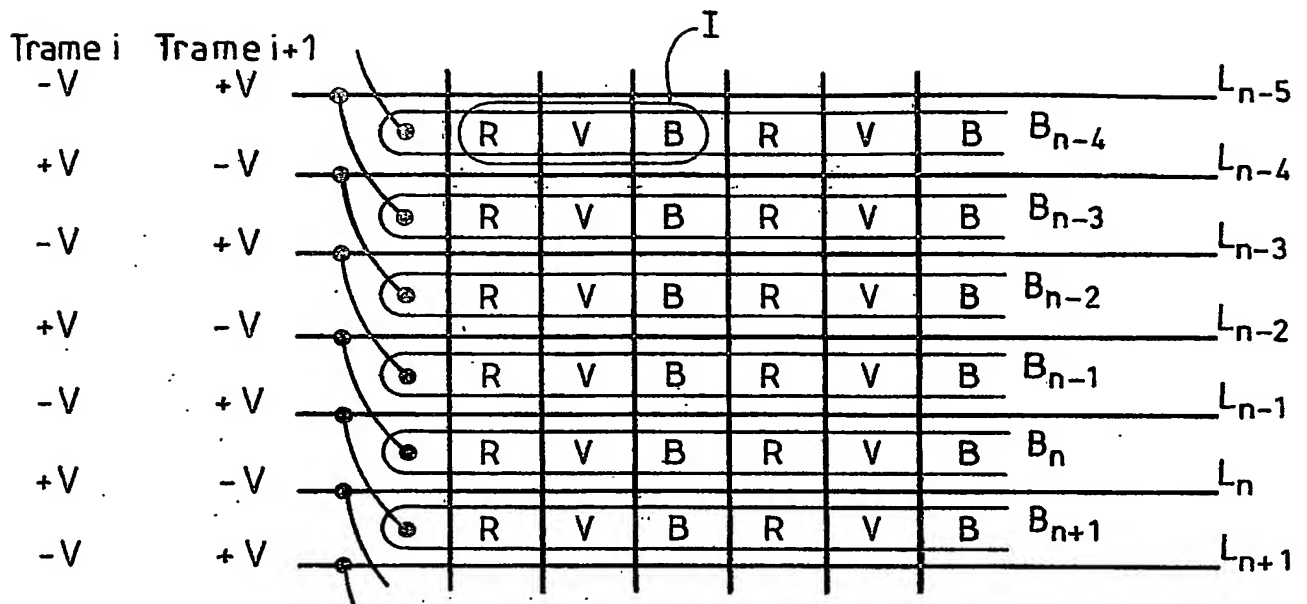


FIG.9

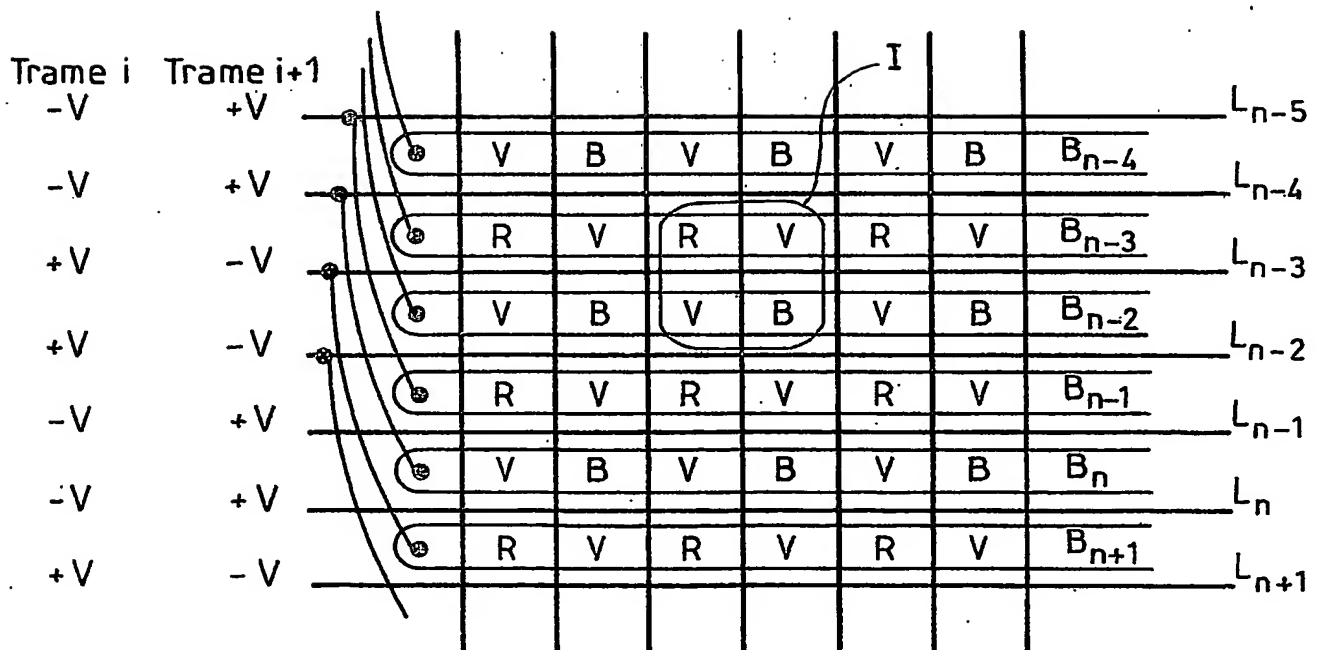


FIG.10

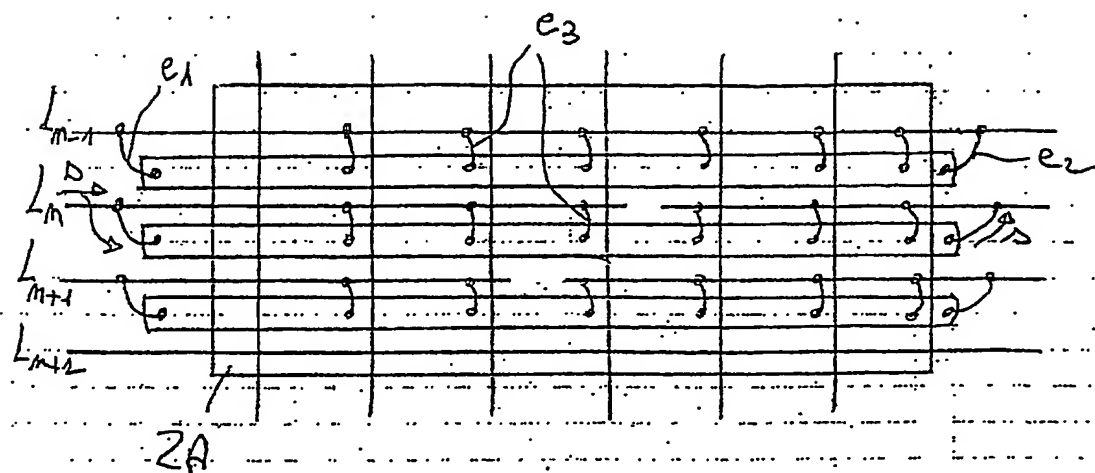


FIG. 11

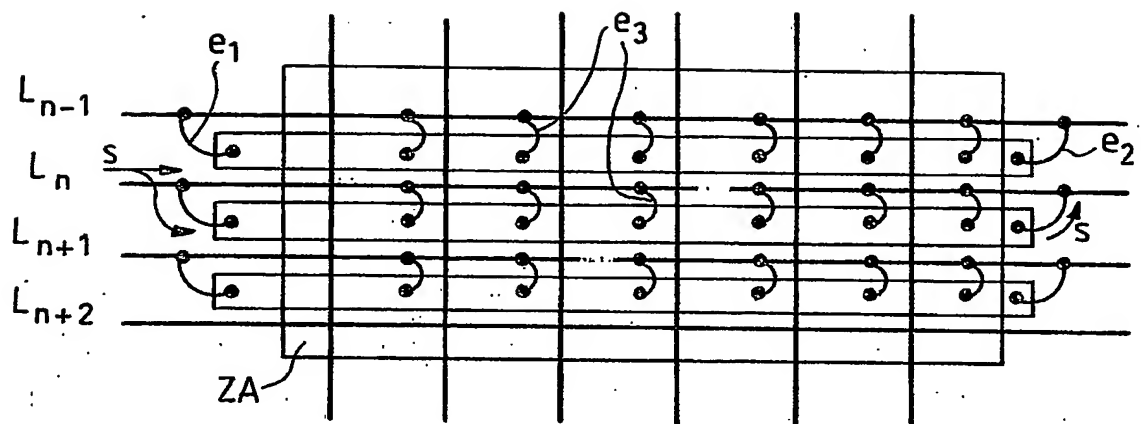


FIG.11



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

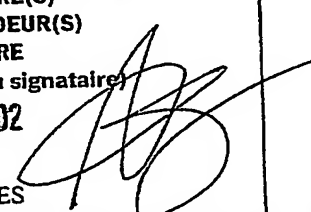
BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI


N° 11235'02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1..
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

03 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		62934	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
STRUCTURE DE MATRICE ACTIVE POUR ECRAN DE VISUALISATION ET ECRAN COMPORTANT UNE TELLE MATRICE			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
THALES			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		KRETZ	
Prénoms		Thierry	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13 avenue du Président Salvador Allende	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LEBRUN	
Prénoms		Hugues	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13 avenue du Président Salvador Allende	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
03 DEC. 2002 Agnès DESVIGNES			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/EP2003/050918



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☒ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.